

CM1137-CBS 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能

• 过充电保护电压	4.425 V	精度 ± 25 mV
• 过充电解除电压	4.225 V	精度 ± 50 mV
• 过放电保护电压	2.900 V	精度 ± 80 mV
• 过放电解除电压	3.100 V	精度 ± 100 mV
• 放电过流检测	2.0 A	精度 ± 0.5 A
• 短路电流检测	3.4 A	精度 ± 1.5 A
• 充电过流检测	2.0 A	精度 ± 0.5 A

2) 内部检测延迟时间

• 过充电保护延时	1.0 s	精度 $\pm 30\%$
• 过放电保护延时	32 ms	精度 $\pm 30\%$
• 放电过流保护延时	10 ms	精度 $\pm 30\%$
• 充电过流保护延时	10 ms	精度 $\pm 30\%$

3) 充电器检测及负载检测功能

4) 过温保护功能

5) 向 0V 电池充电功能

禁止

6) 休眠功能

有

7) 放电过流状态的解除条件

断开负载

8) 放电过流状态的解除电压

 V_{RIOV}

9) 低电流消耗

• 工作时	1.3 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
• 休眠时	50 nA (最大值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)

10) 内部功率 N-MOSFET 导通阻抗 $R_{SS(ON)}$

65 m Ω

11) RoHS、无铅、无卤素

■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电电池

■ 封装

- SOT23-5

■ 系统功能框图

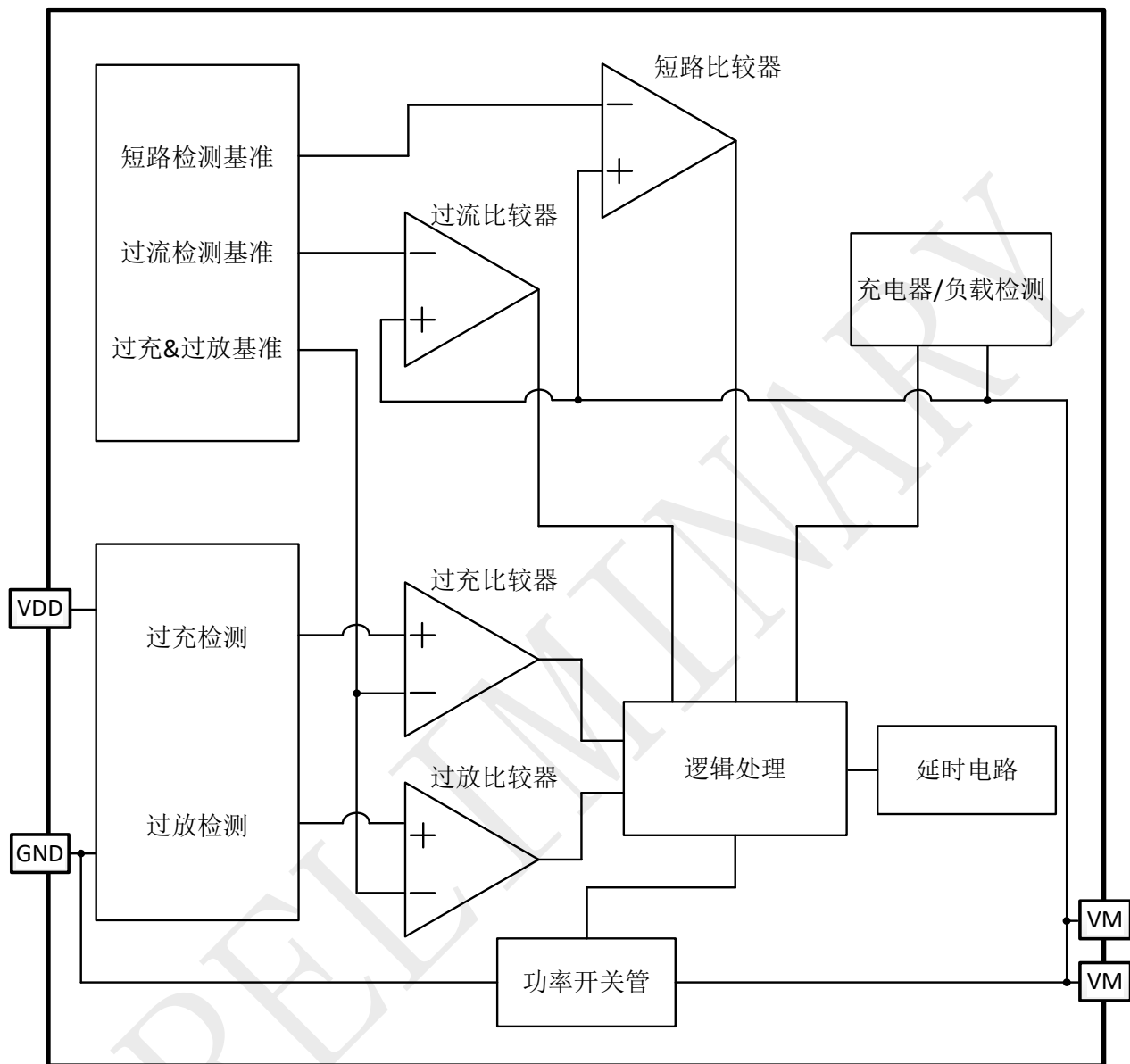


图 1

■ 引脚排列图

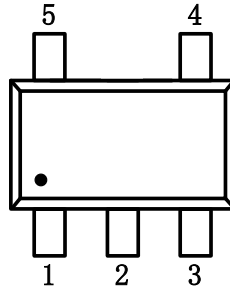


图 2 顶视图

引脚号	符号	描述
1	NC	无连接
2	GND	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
3	VDD	电源端
4, 5	VM	充放电电流检测端子，与充电器负极或负载连接

表 1

■ 印字说明

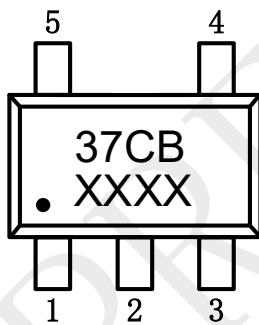


图 3

第一行：产品型号代码
第二行：生产批次

■ 产品列表

1. 检测电压表

产品名称	$R_{SS(ON)}$	过充电 保护电压 V_{OC}	过充电 解除电压 V_{OCR}	过放电 保护电压 V_{OD}	过放电 解除电压 V_{ODR}	放电过流 检测电流 I_{DI}	短路电流 检测电流 I_{SHORT}	充电过流 检测电流 I_{CI}
CM1137-CBS	65 m Ω	4.425 V	4.225 V	2.900 V	3.100 V	2.0 A	3.4 A	2.0 A

表 2

2. 功能列表

产品名称	过充自恢复功能	休眠功能	向 0V 电池充电功能	放电过流状态的 解除条件	放电过流状态的 解除电压
CM1137-CBS	有	有	禁止	断开负载	V_{RIOV}

表 3

3. 延迟时间

产品名称	过充电保护延时 T_{OC}	过放电保护延时 T_{OD}	放电过流延时 T_{DI}	充电过流延时 T_{CI}	短路延时 T_{SHORT}
CM1137-CBS	1000 ms	32 ms	10 ms	10 ms	250 μ s

表 4

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^{\circ}\text{C}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 GND 之间输入电压	VDD	-0.3 ~ 8.0	V
VM 输入端子电压	V _{VM}	-6 ~ 10	V
工作温度范围	T _{OPR}	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T _{STG}	-55 ~ +125	°C
ESD HBM 模式	-	4000	V

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外：Ta = +25°C)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I _{OPE}	VDD=3.6V, V _{VM} =0V	0.6	1.3	2.0	μA
休眠电流	I _{PDN}	VDD=1.5V, V _{VM} =1.5V	-	-	50	nA
[检测电压]						
过充电保护电压	V _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	4.400	4.425	4.450	V
过充电解除电压	V _{OCR}	VDD=4.8 → 3.5V	4.175	4.225	4.275	V
过放电保护电压	V _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	2.800	2.900	3.000	V
过放电解除电压	V _{ODR}	VDD=2.0 → 3.5V	3.000	3.100	3.200	V
放电过流解除电压	V _{RIOV}	-	VDD-1.4	VDD-1.0	VDD-0.6	V
[检测电流]						
放电过流检测	I _{DI}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	1.50	2.00	2.50	A
短路电流检测	I _{SHORT}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	1.90	3.40	4.90	A
充电过流检测	I _{CI}	VDD=V _{OD} ~V _{OC}	1.50	2.00	2.50	A
[延迟时间]						
过充电保护延时	T _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	700	1000	1300	ms
过放电保护延时	T _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	22	32	42	ms
放电过流保护延时	T _{DI}	VDD=3.6V	7	10	13	ms
充电过流保护延时	T _{CI}	VDD=3.6V	7	10	13	ms
短路保护延时	T _{SHORT}	VDD=3.6V	100	250	400	μs
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R _{VMD}	VDD=2V, V _{VM} =0V	135	270	540	kΩ
VM 端子-GND 端子间电阻	R _{VMS}	VDD=3.6V, V _{VM} =1.0V	10	20	30	kΩ
内部功率 N-MOSFET 阻抗	R _{SS(ON)}	VDD=3.6V, I _{VM} =0.1A	50	65	80	mΩ
[向 0V 电池充电的功能]						
电池电压 (禁止向 0V 电池充电功能)	V _{OIN}	禁止向 0V 电池充电功能	0.9	1.2	1.5	V

表 6

■ 功能说明

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与GND端子之间电池电压，以及流过VM到GND端子之间的电流，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压（ V_{OD} ）以上并在过充电保护电压（ V_{OC} ）以下，且流过VM端子到GND的电流在充电过流保护阈值（ I_{CI} ）和放电过流保护阈值（ I_{DI} ）之间时，IC内部的MOSFET导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时需要连接充电器进行激活，充电器激活电压为4.5V~5V，激活时间不能低于10ms，激活后可恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压（ V_{OC} ），并持续时间达到过充电电压检测延迟时间（ T_{OC} ）或更长，IC内部的MOSFET会关闭，并停止充电，这种情况称为过充电电压保护。

过充电状态在如下两种情况下可以解除：

- 1) $VM < V_{LD}$ ，电池电压降低到过充电解除电压（ V_{OCR} ）以下时，过充电状态就会释放。
- 2) $VM > V_{LD}$ ，当电池电压降低到过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

此处的（ V_{LD} ）= $I_{DI} \cdot R_{SS(ON)}$ ，就是IC内部设置的负载检测电压。

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池在放电过程中，当电池电压降低到过放电保护电压（ V_{OD} ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间（ T_{OD} ）时，IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这就称为过放电状态。

当IC内部的MOSFET关闭后，VM会被内部上拉电阻 R_{VMD} 上拉到VDD，IC功耗降低至 I_{PDN} ，这个状态称之为休眠状态。不连接充电器， $VM \geq 0.7V$ （典型值），即使VDD高于 V_{ODR} 也将会维持过放状态。

进入过放电状态后，要解除过放电状态，恢复正常状态，有以下几种情况：

- 1) 连接充电器，若 $0V$ （典型值） $< VM < 0.7V$ （典型值），当电池电压高于过放解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) 连接充电器，若 $VM < 0V$ （典型值），此时，若电池电压低于 $1.6V$ （典型值），放电MOSFET仍然是关闭状态；当电池电压高于 $1.6V$ （典型值）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称作充电器检测功能。

4. 放电过流状态

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果放电电流超过放电电流限流值（ I_{DI} ），并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间（ T_{DI} ），IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。如果放电电流超过短路保护电流值，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间（ T_{SHORT} ），IC内部的MOSFET会关闭，并停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{RIOV} ”。

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与GND端子间可通过 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复至GND端子电压。当VM端子电压降低到 V_{RIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流保护

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果流过GND到VM的电流值超过充电过流保护值（ I_{CI} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ T_{CI} ），则IC内部的MOSFET会关闭，并停止充电，这个状态称为充电过流状态。进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使流过GND到VM端子电流低于充电过流保护值（ I_{CI} ）时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向 0V 电池充电功能（禁止）

此功能用于禁止对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当电池电压低于“0V 电池充电禁止的电池电压 (V_{0IN})”时，充电控制用 MOSFET 关闭，禁止充电。当电池电压高于“0V 电池充电禁止的电池电压 (V_{0IN})”时，可以充电。

注意： 请问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向 0V 电池充电”的功能，还是“禁止向 0V 电池充电”的功能。

PRELIMINARY

■ 典型应用原理图

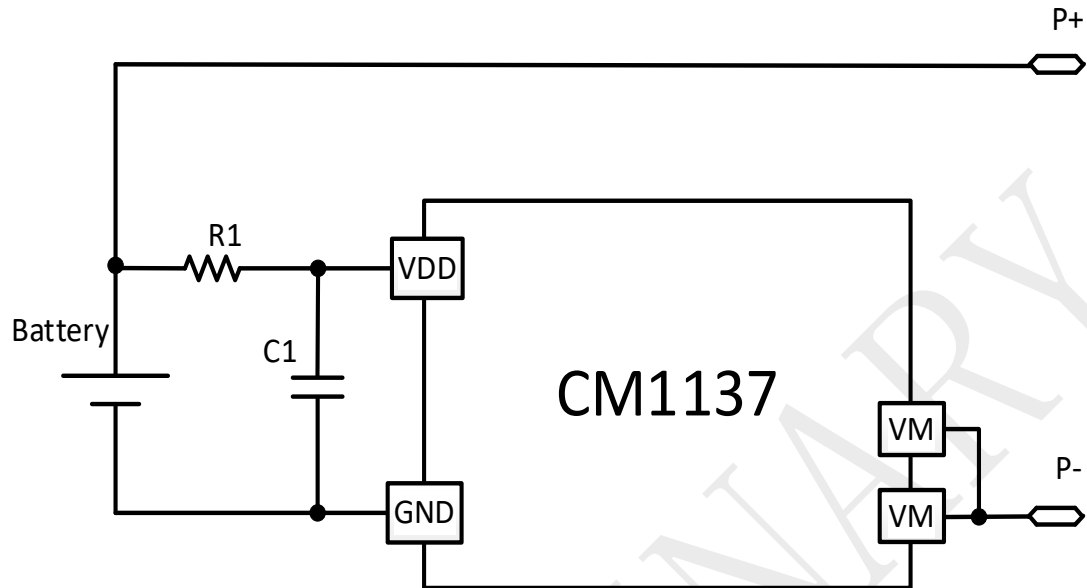


图 4

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	1000	510 ~ 1500	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 0.220	μF

表 7

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

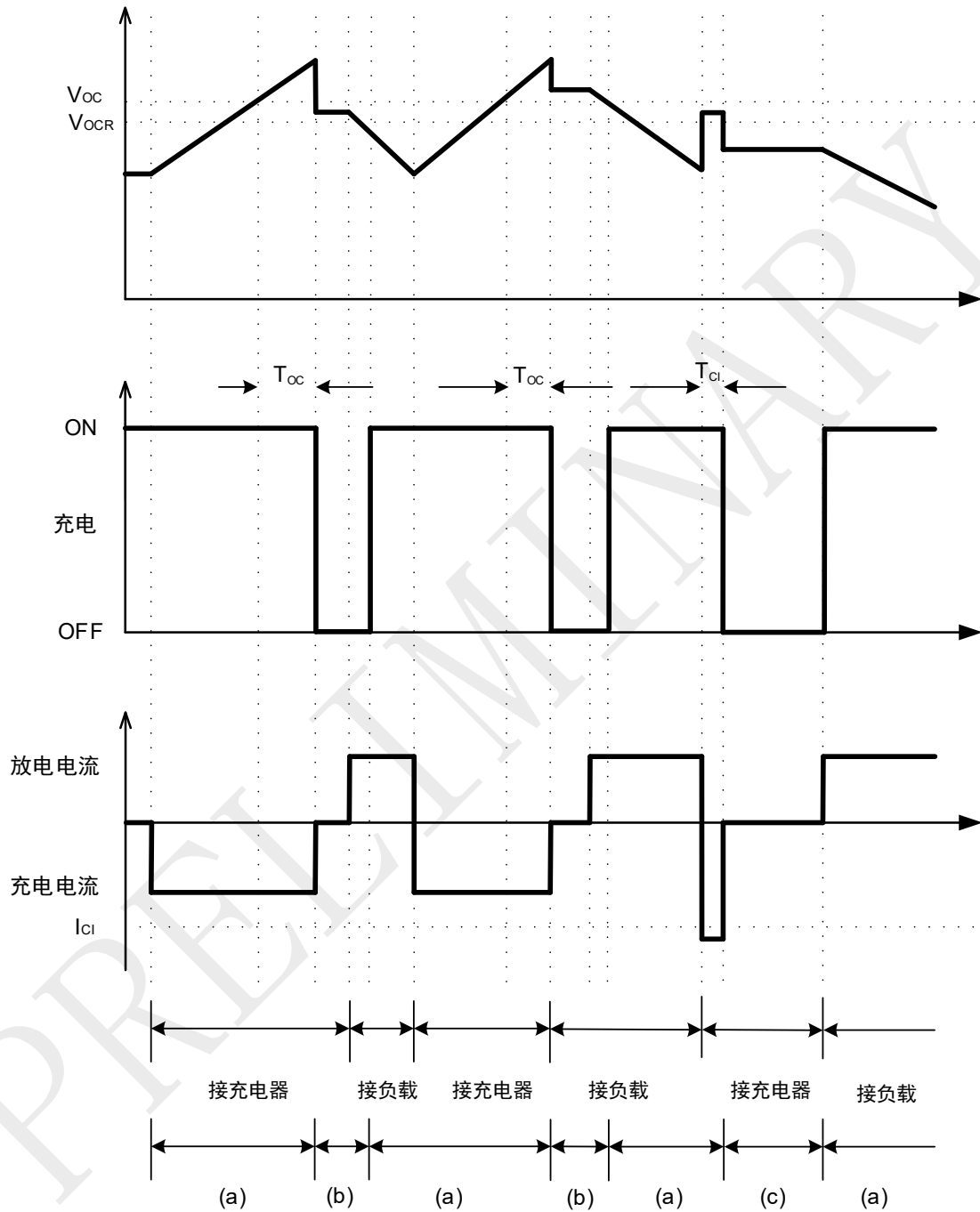


图 5

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

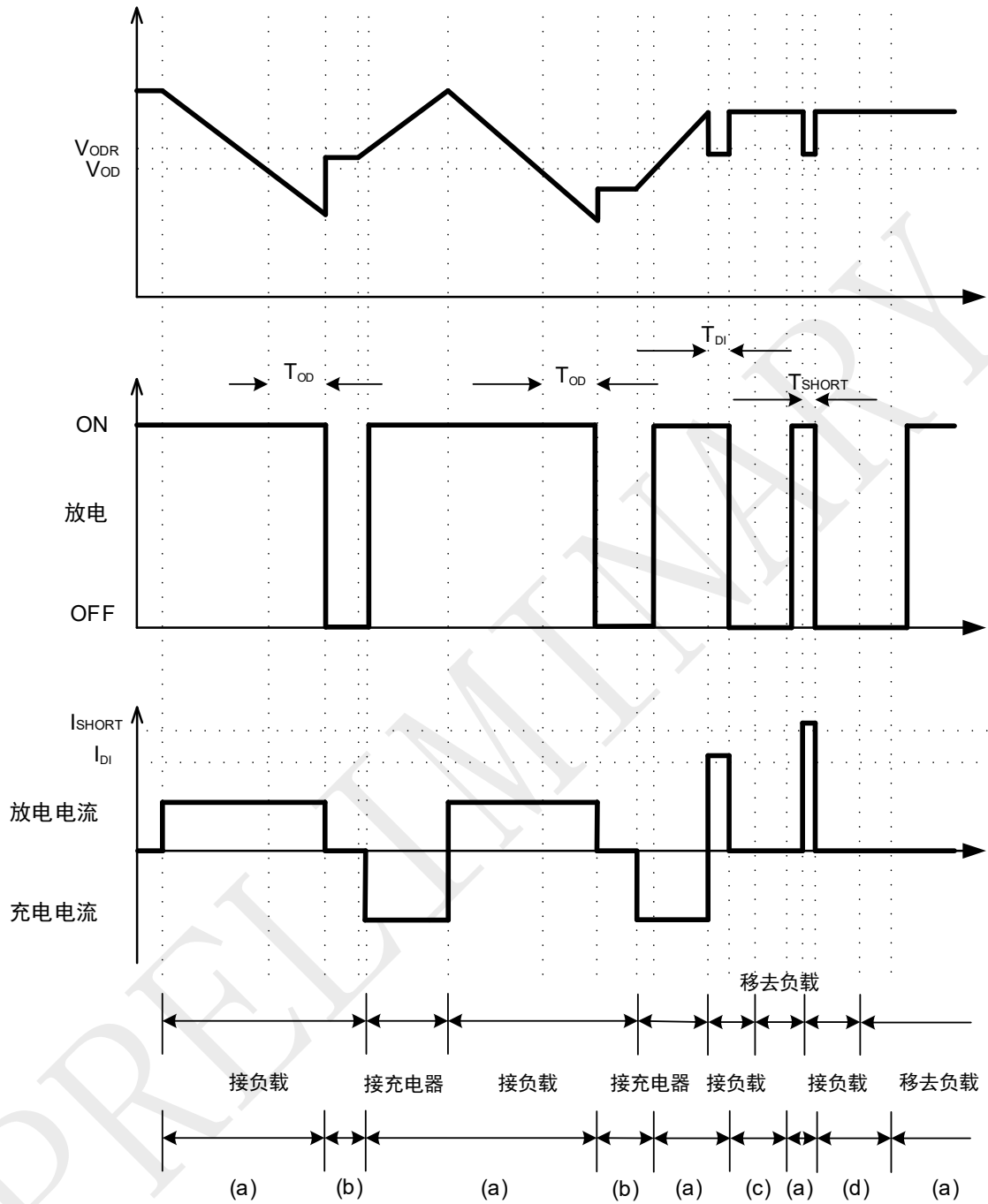


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 封装信息

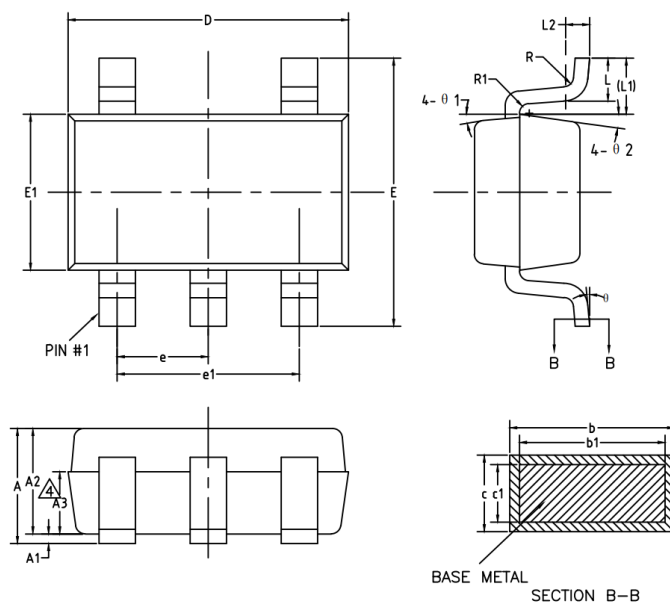


图 7

单位: mm

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.45
A1	0	-	0.15
A2	0.90	1.15	1.30
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.49
b1	0.35	0.40	0.45
c	0.08	-	0.22
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.70	2.90	3.10
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.40	1.60	1.80
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L1	0.60REF		
L2	0.25BSC		
R	0.10	-	-
R1	0.10	-	0.25
θ	0°	-	8°
θ1	7°	9°	11°
θ2	8°	10°	12°

表 8

■ PCB 尺寸推荐

SOT23-5

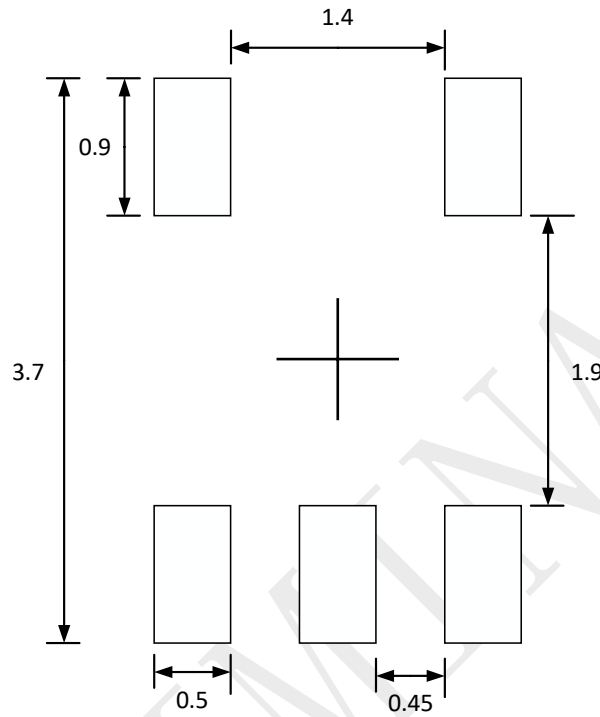


图 8

注意：1.请勿在塑封体下印刷丝网、焊锡，避免产品被顶起。

2.钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘对齐。

3.请向引脚的前端方向扩展焊盘模式。

4.请勿向封装中间的范围扩大焊盘模式。

■ 载带信息

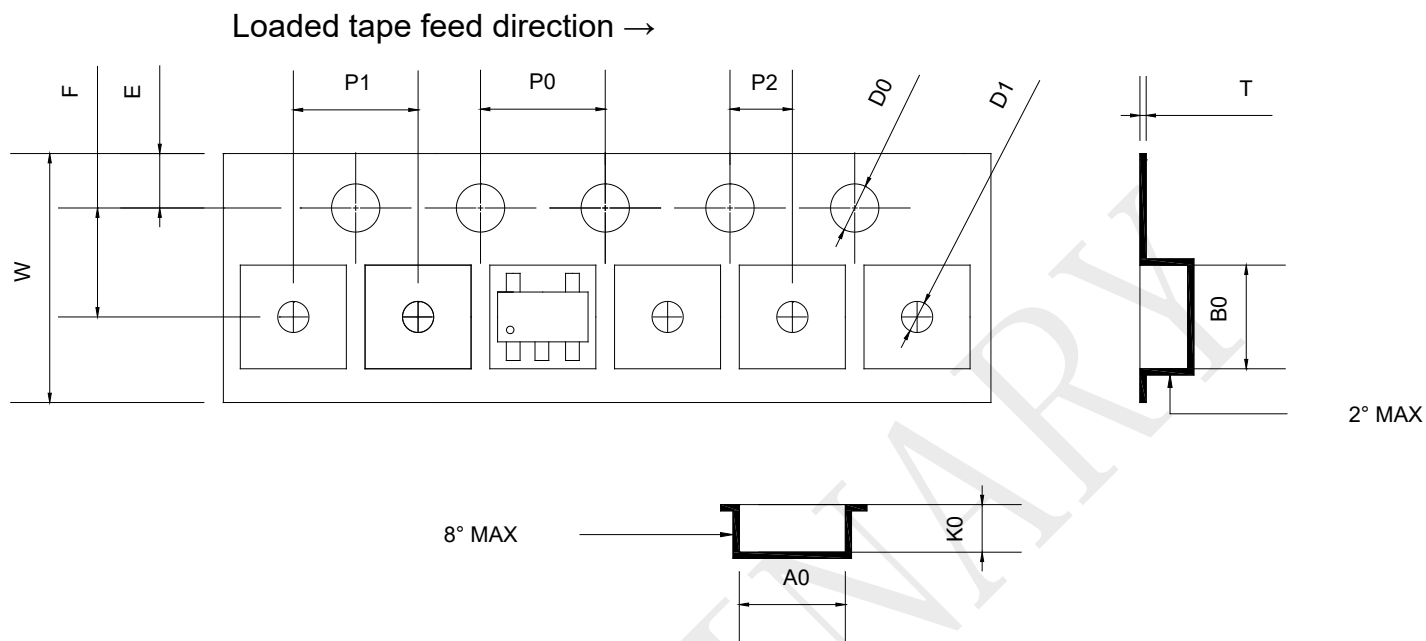


图 9

Type	W*P1	Unit
SOT23-5L	8.0*4.0	mm
Item	Specification	Tol. (+/-)
W	8.00	±0.10
F	3.50	±0.05
E	1.75	±0.10
P2	2.00	±0.05
P1	4.00	±0.10
P0	4.00	±0.10
P0*10	40.00	±0.20
D0	1.50	+0.10/-0
D1	1.00	+0.10/-0
T	0.20	±0.05
B0	3.33	±0.10
A0	3.40	±0.10
K0	1.53	±0.10

表 9

卷盘信息

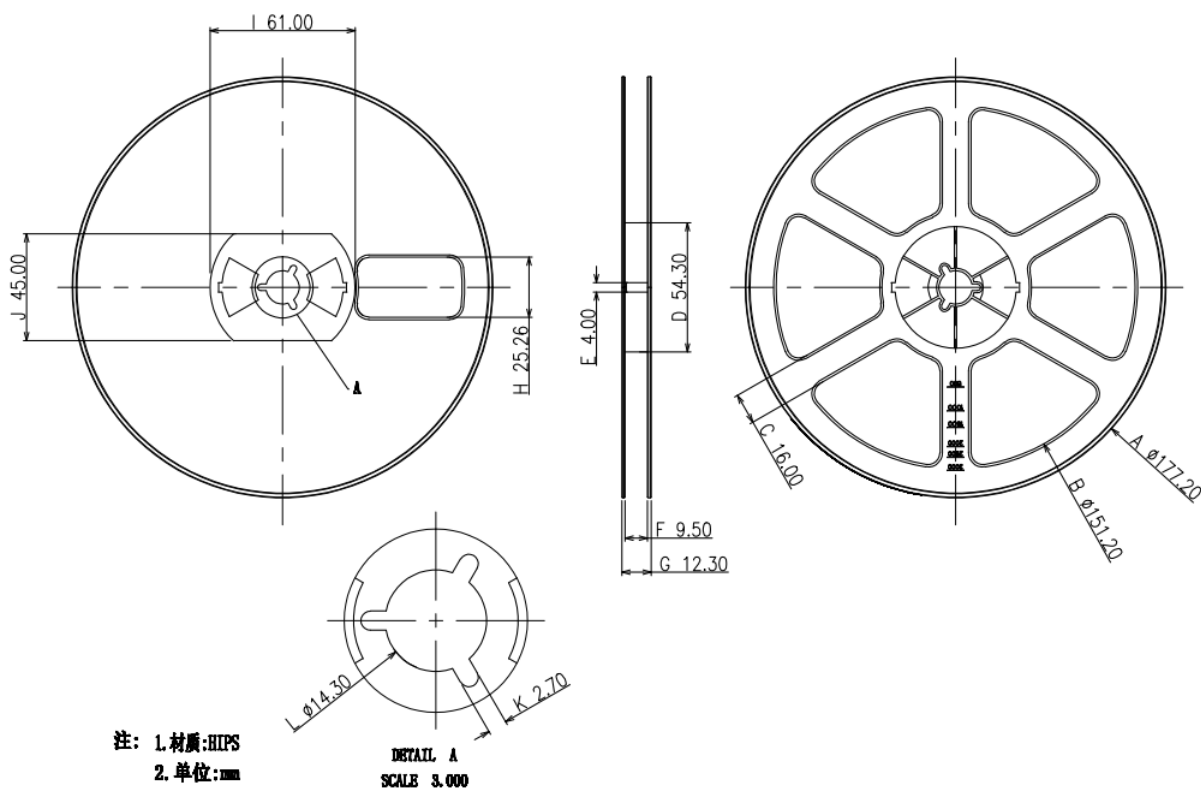


图 10

包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7"	3000	10	4

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。